

# SC 111

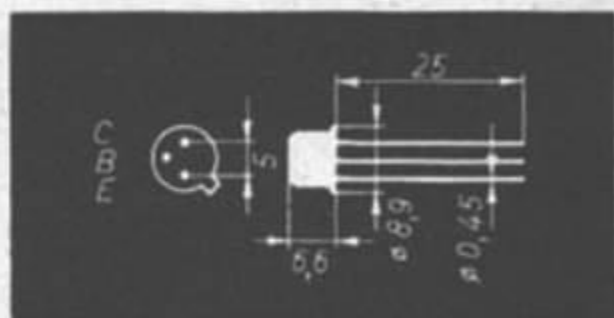
Verwendung: Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Niederfrequenz-Transistor für Vor- und Treiberstufen bei Umgebungstemperaturen  $\theta_a$  von  $-40^\circ\text{C}$  bis  $+125^\circ\text{C}$

Abmessungen: Bauform B 3/25a, TGL 11 811

Masse  $\approx 1$  g

Zulässige Höchstwerte bis  $\theta_{jmax}$

$U_{CBO} = 30$ V	$P_{tot} = 2,5$ W
$U_{CEO} = 20$ V	bei $\theta_c = 25^\circ\text{C}$
$U_{EBO} = 5$ V	$\theta_j = 175^\circ\text{C}$
$I_C = 200$ mA	$\theta_a = 125^\circ\text{C}$
$P_{tot} = 600$ mW	
bei $\theta_a = 25^\circ\text{C}$	



Wärmewiderstand  $R_{th} \leq 250 \frac{\text{grad}}{\text{W}}$

$R_{thl} \leq 60 \frac{\text{grad}}{\text{W}}$

Kennwerte für  $\theta_a = 25^\circ\text{C} - 5$  grad

	Min.	Typ	Max.	Meßbedingungen	Stromverstärkungsgruppen
<b>Restströme</b>					
$I_{CBO}$			25 nA	$U_{CB} = 15$ V	
<b>Durchbruchspannungen</b>					
$U_{(BR)CBO}$	30 V			$I_C = 5 \mu\text{A}$	
$U_{(BR)CEO}$	20 V			$I_C = 50$ mA	
$U_{(BR)EBO}$	5 V			$I_E = 5 \mu\text{A}$	
<b>Stromverstärkung</b>					
$h_{21e}$	18		35	$U_{CE} = 6$ V, $I_C = 2$ mA, $f = 1$ kHz	a
$h_{21e}$	29		70		b
$h_{21e}$	57		139		c
$h_{21e}$	113		276		d
$h_{21e}$	226		550		e
<b>Übergangsfrequenz</b>					
$f_T$	60 MHz			$U_{CE} = 10$ V, $I_C = 10$ mA, $f = 15$ MHz	
<b>Rauschfaktor</b>					
F			8 dB	$U_{CE} = 6$ V, $I_C = 0,2$ mA, $f = 1$ kHz, $R_g = 500 \Omega$	

Bestellbeispiel für einen Transistor

Transistor SC 111

